
	<h2 style="color: red;">FQP11P06</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP11P06</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 11.4A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP11P06.pdf</a> <a href="#">2.FQP11P06.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 41177 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP11P06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 11.4A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	41177 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	52 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 11.4A (Tc) 53W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	53W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	175 mOhm @ 5.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP11P06 ist neu im Original, Suche FQP11P06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP11P06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP11P06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP12N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP12N40</b> FAIRCHILD FQP12N40 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQP11N50CF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11A TO-220</p>	 <p><b>FQP11N65C</b> VB FQP11N65C VB</p>
 <p><b>FQP11N60C</b> VB FQP11N60C VB</p>	 <p><b>FQP12N50</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO-220</p>	 <p><b>FQP11P06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 11.4A TO-220</p>	 <p><b>FQP11N60</b> Original FQP11N60 Original</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP10N20	↔ FQP10N20	⇒ FQP10N20C	D FQP10N20C	↗ FQP10N20L
⊥ FQP10N60B	⊗ FQP10N60C	D FQP10N60C	⇒ FQP10N60CF	↗ FQP10N60C_07
⊗ FQP10N65	⊥ FQP10N65C	⊗ FQP10N80	↔ FQP11N40C	↗ FQP11N40C
D FQP11N50CF	⊗ FQP11N50CF	⊥ FQP11N60	⊗ FQP11N60C	↗ FQP11N65C
⇒ FQP11P06	↔ FQP12N20	⊗ FQP12N60	⊥ FQP12N60	↗ FQP12N60C
↔ FQP12N60C	⇒ FQP12N65C	D FQP12P10	⊗ FQP12P10	⊥ FQP12P20
⊗ FQP12P20	D FQP13N06	⇒ FQP13N06	↔ FQP13N06L	↗ FQP13N06L
⊥ FQP13N10	⊗ FQP13N10	↔ FQP13N10L	⇒ FQP13N10L	↗ FQP13N50
⊗ FQP13N50	⊥ FQP13N50C	⊗ FQP13N50C	D FQP13N60C	↗ FQP140N03
↔ FQP140N03L	⊗ FQP14N15	⊥ FQP14N15	⊗ FQP14N30	↗ FQP14N30

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited